



特点:

- 频率范围: 10MHz~52MHz (固定值)
- 高频率精度, 高频率温度稳定性
- 宽工作温度, -55°C~125°C
- 高可靠性、抗振动和冲击
- 表面贴装, SMD3.2mm×2.5mm×0.9mm

应用:

- 自动控制
- 测试仪器与设备
- 导航系统
- 机载、弹箭载等平台

电性能参数

型号: TX32B	
频率范围 (MHz)	10~52
电源电压 V_{DD} (V)	3.3±0.16(E); 2.5±0.12(J)
输出波形	CMOS 方波 (C)
工作电流 (mA)	≤25
基准温度下初始准确度 ($\times 10^{-6}$) (@25°C±2°C)	≤±1(B); ≤±2(C); ≤±3(D); ≤±5(E)
频率温度稳定性 ($\times 10^{-6}$)	见频率温度稳定性表
工作温度范围 (°C)	见频率温度稳定性表
可工作温度范围 (°C)	-55~125
输出电压 (V)	“1”电平≥90% V_{DD} ; “0”电平≤10% V_{DD}
频率电压允差 ($\times 10^{-6}$) (@ $V_{DD}\pm 5\%$)	≤±0.2
频率负载允差 ($\times 10^{-6}$) (@负载±5%)	≤±0.2
额定负载	CL=15pF
相位噪声 ($f_0=10\text{MHz}$)	≤-115dBc/Hz@100Hz
	≤-135dBc/Hz@1KHz
	≤-148dBc/Hz@100KHz
压控特性	N:无压控; V:有压控
	频率调谐范围: ≥±3×10 ⁻⁶ ; 压控中心电压: +1.5V (可定制)
老化 ($\times 10^{-6}$ /年)	≤±0.7
三态控制(1脚)	使能: ≥70% V_{DD} (高电压或悬空);
	禁止: ≤30% V_{DD} (低电压或地).
外形尺寸 (mm)	3.2mm×2.5mm×0.9mm
封装形式	陶瓷封装

(备注: 在可工作温度范围内, 晶振可以工作。)

质量等级

军级	B
普军级	C
其它：七专级（G）、工业级（I）	

技术标准

总规范	GJB 1648A-2011
详细规范	Q/SYFC 50610-2022
	Q/SYFC 50611-2022

频率温度稳定性

温度范围		频率温度稳定性 ($\times 10^{-6}$)		
		C(± 2)	D(± 3)	E(± 5)
C	-20°C~70°C	√	√	√
D	-40°C~85°C	√	√	√
E	-55°C~85°C	×	×	△

(备注：“√”表示常规指标；“△”表示需定制；“×”表示无法提供)

外形尺寸及引脚定义

底视图

侧视图

顶视图

结构尺寸 (mm)

推荐焊盘尺寸 (mm)

(注: 0.1µF电容尽可能靠近晶振的4脚)

引脚	符号	功能描述
1	Tri-State	三态控制
2	GND	地
3	OUT	输出
4	VDD	电源电压

标识说明:

- 第一行：“XXX.XXM”为标称频率，如100.00M；
- 第二行：“o”为1脚标识；

“FC”为公司标识；
“XXXX”为批次号，由“年”、“周”组成。

订货信息

